

2SK1902

NチャンネルMOS形シリコン電界効果トランジスタ
超高速スイッチング用

暫定規格

- 特長
- ・低オン抵抗。
 - ・超高速スイッチング。
 - ・低電圧駆動。

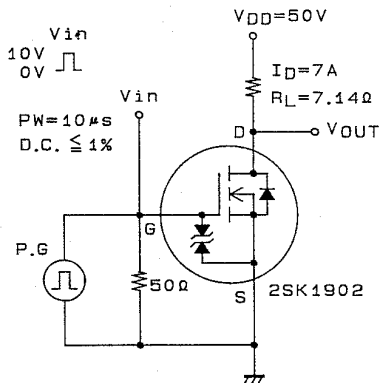
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25°C

			unit
ドレイン・ソース電圧	V _{DSS}	100	V
ゲート・ソース電圧	V _{GSS}	±20	V
ドレイン電流 (DC)	I _D	15	A
ドレイン電流 (パルス)	I _{DP}	PW ≤ 10μs, duty cycle ≤ 1%	60
許容損失	P _D	Tc = 25°C	60
チャンネル温度	Tch		150
保存周囲温度	Tstg		-55~+150

電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25°C

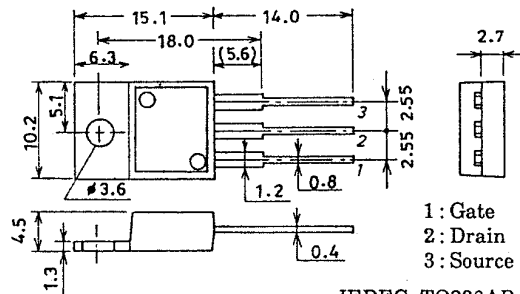
		min	typ	max	unit
ドレイン・ソース降伏電圧	V _{(BR)DSS}	I _D = 1mA, V _{GS} = 0	100		V
ゲート・ソース降伏電圧	V _{(BR)GSS}	I _G = ±100μA, V _{DS} = 0	±20		V
ドレイン・ソースしゃ断電流	I _{DSS}	V _{DS} = 100V, V _{GS} = 0		100	μA
ゲート・ソースもれ電流	I _{GSS}	V _{GS} = ±16V, V _{DS} = 0		±10	μA
カットオフ電圧	V _{GS(off)}	V _{DS} = 10V, I _D = 1mA	1.0	2.0	V
順伝達アドミタンス	Y _{fs}	V _{DS} = 10V, I _D = 7A	7	11.5	S
ドレイン・ソース間オン抵抗	R _{DS(on)}	I _D = 7A, V _{GS} = 10V	100	135	mΩ
	R _{DS(on)}	I _D = 7A, V _{GS} = 4V	135	180	mΩ
入力容量	C _{iss}	V _{DS} = 20V, f = 1MHz	1230		pF
出力容量	C _{oss}	V _{DS} = 20V, f = 1MHz	200		pF
帰還容量	C _{rss}	V _{DS} = 20V, f = 1MHz	40		pF
ターンオン遅延時間	t _{d(on)}	下図指定回路において	14		ns
立ち上がり時間	t _r	"	21		ns
ターンオフ遅延時間	t _{d(off)}	"	230		ns
下降時間	t _f	"	90		ns
ダイオード順電圧	V _{SD}	I _S = 15A, V _{GS} = 0	1.0	1.5	V

スイッチングタイム測定回路



A05696

外形図 2052C
(unit: mm)



1: Gate
2: Drain
3: Source

JEDEC: TO220AB
EIAJ: SC46

本製品は開発中です。
詳細については営業担当者にご連絡ください。